

平成 23 年 11 月吉日

各 位

名古屋大学赤崎記念研究センター
センター長 天野 浩

第 11 回赤崎記念研究センターシンポジウム並びに懇親会のご案内

拝啓 仲秋の候、皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

今年も赤崎記念研究センターシンポジウムを開催する時期がやって参りました。本シンポジウムは 2001 年の第 1 回開催から数えて第 11 回目となりました。これまでの開催主旨を引き継ぎ、窒化物半導体の新たな展開をテーマとして関係の先生方にご講演をお願いしております。皆様のご参加を頂きますようご案内申し上げます。

このたびも、名古屋大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー（ラボラトリー長 八島栄次教授）、日本学術振興会「ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第 162 委員会」（委員長 吉川明彦教授）、名城大学窒化物半導体研究センター（センター長 赤崎 勇教授）の協賛を得ての開催を予定しております。ご関係の皆様方に御礼を申し上げます。

シンポジウム終了後、懇親会を企画致しました。本センター設立と運営に多大なお力を頂いております赤崎勇先生を囲んで歓談のひとつときをお過ごしいただけますよう、多数のご参会をお待ち申し上げます。

敬具

記

第 11 回 赤崎記念研究センターシンポジウム

主催：名古屋大学 赤崎記念研究センター

協賛：名古屋大学 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー

日本学術振興会「ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第 162 委員会」

名城大学窒化物半導体研究センター

1. 日 時： 平成 23 年 12 月 09 日（金） 10:00 ～ 17:30
17:40 ～ 懇親会
2. 場 所： 名古屋大学東山キャンパス ES ホール（ES 総合館）
名古屋市千種区不老町 TEL：052-789-3321
<http://www.nagoya-u.ac.jp/global-info/access-map/higashiyama/>
地下鉄名城線名古屋大学駅下車西地区連絡通路出口より、
横断歩道を渡ってすぐ
3. テーマ： 「窒化物半導体研究の新展開：新規デバイスの創出をめざして」
（プログラム別紙）
4. 連絡先： 名古屋大学大学院工学研究科 電子情報システム専攻 天野研究室：江口
464-8603 名古屋市千種区不老町 C3-1
TEL：052-789-3321 FAX：052-789-3157
e-mail：eguchi@nuee.nagoya-u.ac.jp

**11th Akasaki Research Center Symposium
"To the New Horizon of the Nitride Research"**

**Friday, December 9, 2011
E & S Hall (E & S Building), Nagoya University**

Organized by
Nagoya University Akasaki Research Center
In cooperation with
Nagoya University Venture Business Laboratory
JSPS 162nd Committee on Wide Bandgap Semiconductor Photonic and Electronic Devices
Meijo University Research Center for Nitride Semiconductors

【1】 Reports from Members

10:00-10:20

“Reduction of dislocations and residual stress in GaN grown on patterned Si substrates”
T. Tanikawa, T. Mitsunari, M. Kushimoto, Y. Honda, M. Yamaguchi, H. Amano (*Nagoya University*), N. Sawaki (*Aichi Institute of Technology*)

10:20-10:40

“Improvement of the electrical properties of Al₂O₃/AlGaIn/GaN MOSHFETs by (NH₄)₂S surface treatments”
E. Miyazaki and T. Mizutani (*Nagoya University*)

10:40-11:00

“Development of X-ray diffractometer for X-ray CTR measurement using Johansson monochromator and quick measurements”
M. Masuda, H. Futaki, T. Kawase, M. Tabuchi, and Y. Takeda (*Nagoya University*)

11:00-11:20

“Homoepitaxial growth of AlN on sublimation growth substrate by low-pressure HVPE”
K. Hiramatsu, T. Nomura, H. Miyake (*Mie University*), Y. Yamada (*Yamaguchi University*)

11:20-11:40

“MOVPE growth of III-nitrides analyzed using a novel in-situ X-ray diffraction system”
M. Iwaya, D. Tanaka, D. Iida, T. Takeuchi, S. Kamiyama, and I. Akasaki (*Meijo University*)

11:40-13:00 Lunch

【2】 Invited Speakers Presentations

13:00-14:00

“Recent Progress on GaN-based Nanocolumn Emitters and Related Technologies”
K. Kishino, K. Yamano, J. Kamimura, S. Ishizawa, T. Kouno, A. Kikuchi, K. Nagashima (*Sophia University*) and K. Kamiyama (*Toyohashi University of Technology*)

14:00-15:00

“Proposal of SMART III-Nitride Tandem Solar Cells with Superstructure Magic Alloys of InN/GaN Short-Period Superlattices”
A. Yoshikawa, K. Kusakabe, Y. Ishitani, and N. Hashimoto (*Chiba University*)

15:00-15:30 Coffee Break

15:30-16:30

“Growth of III-nitride device structures in high throughput MOCVD reactors”
K. Balakrishnan (*Veeco*)

16:30-17:30

“Mg-doping in GaN: Acceptor states and defects”
B. Monemar (*Linköping University*)

17:40-19:30 Buffet Party

第 11 回 赤崎記念研究センターシンポジウム 参加申込書

締め切り

12月02日

日 時： 平成 23 年 12 月 09 日（金） 10:00 ～ 17:30

場 所： 名古屋大学 ES 総合館（名古屋市千種区不老町）

<http://www.nagoya-u.ac.jp/global-info/access-map/higashiyama/>

地下鉄名城線名古屋大学駅下車西地区連絡通路出口より、
横断歩道を渡ってすぐ

懇親会： 平成 23 年 12 月 09 日（金） 17:40 ～ 19:30

会費 3,000 円 （当日申し受けます。）

【シンポジウム参加申込】

氏 名	(フリガナ)	連絡先	TEL:
			FAX:
所 属			
住 所 (勤務先)			
メールアドレス			
懇親会 (3,000 円)	参加	不参加	
氏 名	(フリガナ)	連絡先	TEL:
			FAX:
所 属			
住 所 (勤務先)			
メールアドレス			
懇親会 (3,000 円)	参加	不参加	

送付先： 名古屋大学大学院工学研究科 電子情報システム専攻 天野研究室：江口
464-8603 名古屋市千種区不老町
TEL：052-789-3321 FAX：052-789-3157
e-mail：eguchi@nuee.nagoya-u.ac.jp
(上記内容を電子メールでお知らせ下さっても結構です。)